

会员专区

帐号:

密码:

登录

注册

了解会员服务

广告贴吧

锂离子电池材料

我公司主要从事锂离子正极材料和新型复合金属氧化物的研发、生产与销售

洁纶易纺科技-抗菌纤维

公司致力于抗菌等功能纺织产品开发,是中国抗菌纤维先锋和第一品牌

杉杉科技锂电负极材料

生产中间相炭微球(CMS)等高性能的锂离子电池正负极材料

焦点房产网

买房装修,请到焦点房产网

[发布贴吧广告]

首页 → 材料网刊 → 工艺研究 → 正文

PECVD 法制备氮化硅薄膜的研究进展

王育梅, 吴孟强, 张树人

浏览次数:

(电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室, 成都 610054)

版权所有 不得转载

摘要 等离子增强型化学气相沉积(PECVD)是目前较为理想和重要的氮化硅薄膜制备方法。着重介绍了PECVD 法制备氮化硅薄膜工艺参数的研究进展。

关键词 氮化硅薄膜 PECVD 工艺参数

Research Progress in Preparation of Si₃N₄ Thin Films by PECVD

WANG Yumei, WU Mengqiang, ZHANG Shuren

(State Key Laboratory of Electronic Thin Films and Integrated Devices, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610054)

Abstract Plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) is one of more perfect and important methods to prepare Si₃N₄ thin films. This paper introduces the research progress in processing parameters of the preparation of Si₃N₄ thin films by PECVD.

Keywords Si₃N₄ thin films, PECVD, processing parameters

[点击查看全文](#) 如果您没有安装PDF阅读软件,请点[这里](#)下载

责任编辑:

2008年1月第1期